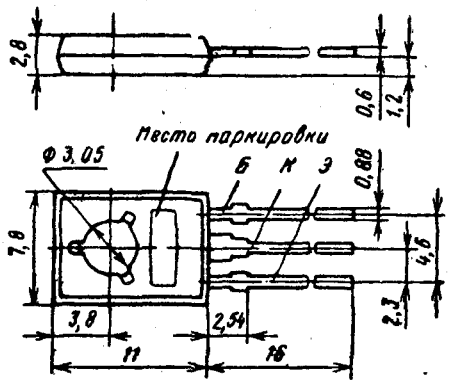


# КТ817 (А, Б, В, Г)

КТ817 (А Г)

Транзисторы кремниевые меза-эпителиально-планарные структуры *n-p-n* усилительные. Предназначены для применения в усилителях низкой частоты, операционных и дифференциальных усилителях, преобразователях и импульсных устройствах. Корпус пластмассовый с жесткими выводами.

Масса транзистора не более 0,7 г.



## Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кэ}=2$ В, $I_э=1$ А, не менее	
$T_n = +25$ и $+100^\circ\text{C}$	25
$T_n = -40^\circ\text{C}$	15
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кэ}=10$ В $I_э=0,25$ А, не менее	3 МГц
Граничное напряжение при $I_э=100$ мА, $t_u \leq 300$ мкс, $Q \geq 100$ , не менее	
КТ817А	25 В
КТ817Б	45 В
КТ817В	60 В
КТ817Г	80 В
Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при $I_к=1$ А, $I_э=0,1$ А, не более	0,6 В
типичное значение	0,15* В
Напряжение насыщения база — эмиттер при $I_к=1$ А, $I_э=0,1$ А, не более	1,5 В
Обратный ток коллектора при $U_{кэ}=U_{кэв, макс}$ , не более	
$T = +25$ и $-40^\circ\text{C}$	100 мкА
$T = +100^\circ\text{C}$	3000 мкА
Емкость коллекторного перехода при $U_{кэ}=10$ В, $f = 1$ МГц, не более	60 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{эв}=0,5$ В, не более	115 пФ

## Предельные эксплуатационные данные

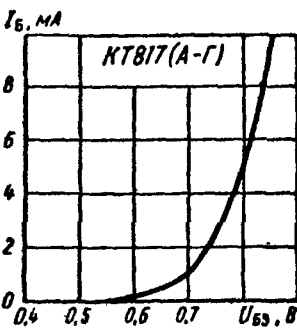
Постоянное напряжение коллектор — эмиттер	
$R_{сэ} = \infty$	
КТ817А	25 В
КТ817Б	45 В
КТ817В	60 В
КТ817Г	80 В
$R_{сэ} \leq 1$ кОм	
КТ817А	40 В
КТ817Б	45 В
КТ817В	60 В
КТ817Г	100 В
Постоянное напряжение база — эмиттер	5 В
Постоянный ток коллектора	3 А
Импульсный ток коллектора при $t_u \leq 20$ мс, $Q \geq 100$	6 А
Постоянный ток базы	1 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора <sup>1</sup> при $T_n = -60...+25^\circ\text{C}$ :	
с теплоотводом	25 Вт
без теплоотвода	1 Вт
Температура <i>p-n</i> перехода	$+150^\circ\text{C}$
Температура окружающей среды	$-40^\circ\text{C}...T_n = +100^\circ\text{C}$

<sup>1</sup> При  $T_n > +25^\circ\text{C}$   $P_{к, макс}$  уменьшается линейно на 0,2 Вт/°C с теплоотводом и на 0,1 Вт/°C без теплоотвода.

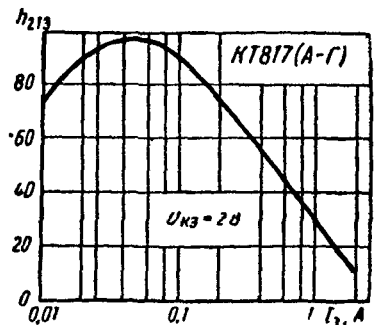
Изгиб выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса транзистора с радиусом закругления 1,5...2 мм; при этом должны приниматься меры, исключающие возможность передачи усилий на корпус. Изгиб в плоскости выводов не допускается.

При монтаже транзисторов на теплоотвод крутящий момент при нажатии не должен превышать 70 Н·см.

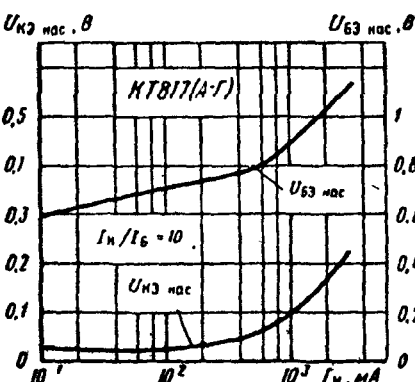
Пайка выводов транзисторов рекомендуется не ближе 5 мм от корпуса.



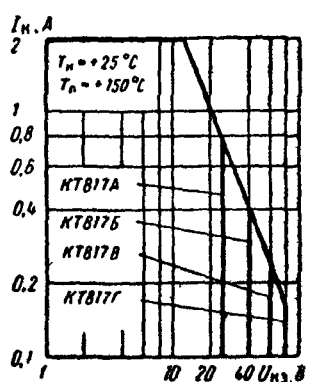
Входная характеристика



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера



Зависимости напряжений насыщения коллектор — эмиттер и база — эмиттер от тока коллектора



Области максимальных режимов